

# Leistungselektronik Cheat Sheet

# 1. Allgemeines

Allgemeines

Tastverhältnis:  $D = \frac{\tau_i}{T}$ 

Funktion einer Sinusspannung:  $u(t) = \hat{U}_s \cdot \sin(\omega t)$ 

Physikalische Größen

Un: Gleichspannung

û: Scheitelwert

u(t): zeitabhängige Spannung

T: Periodendauer

 $t_i$ : Impulszeit

 $\overline{U}$ : Arithmetischer Mittelwert

### 2. Mathematische Verfahren

#### 2.1. Mittel- & Effektivwert

Arith. Mittelwert einer Mischspannung:  $\bar{u}_{di} = U_{di} = \frac{1}{T} \int u_d(t) dt$ 

### Effektivwert einer diskreten Spannung

- 1. Spannung in Spannungen mit gleichem  $\hat{U}$  aufteilen.
- 2. Effektivwerte der Einzelspannungen berechnen:  $U_{xRMS} = \sqrt{D}\hat{U}$ .
- 3. Quadratische Summe aller  $U_{xRMS}$  berechnen:  $U_{RMS} = \sqrt{U_{xRMs}^2 + U_{x+1RMs}^2}$

### 2.2. Welligkeit, Klirr und Formfaktor

Welligkeit (Ripple)

Welligkeit reiner Gleichgrößen: w = 0. Welligkeit reiner Wechselgrößen: w = sehr groß.

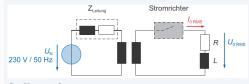
Klirrfaktor (THD)

 $K_U = \frac{U_{RMSOS}}{U_{RMS}}$ 

# Formfaktor $F = \frac{U_{d RMS}}{U_{di}}$

# 3. Leistungsberechnung

## 3.1. Leistungsarten



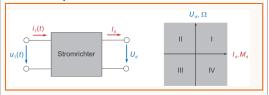
 $S = U_{0RMS} \cdot I_{ORMS}$ 

Für rein sinusförmige Verläufe gilt:

 $\lambda = \frac{P}{S} = \cos \phi$  $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 

 $Q = \sin(\phi)$ 

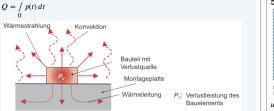
3.2. Betriebsquadranten

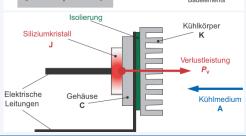


# 4. Wärmemanagement

### 4.1. Verlustleistung

Thermische Energie: Q Momentanleistung am PN Übergang:  $p_v = u \cdot i$ 





Bauelement	Kennbuchstabe	Temperatur
Siliziumkristall - Junction	J	$\vartheta_J$
Gehäuse - case	С	$\vartheta_C$
Kühlkörper - heatsink	K	$\vartheta_K$
Kühlmedien - ambient	A	$\vartheta_A$

# 5. Mittelpunktschaltungen

#### 5.1. Nomenklatur

id ud: Zeitverläufe von Strom und Spannung

 $I_d U_d$ : In den Zeitverläufen von  $i_d$  und  $u_d$  enthaltene Mittelwerte

u<sub>T</sub>: Zeitlicher Verlauf der Spannung an einem Thyristor

us: Zeitlicher Verlauf der Netzspannung

 $U_S$ : Effektivwert der Netzspannung

 $U_N$ : Effektivwert der verketteten Spannung

d: Ausgangsgröße

T: Transistor

S: Strang

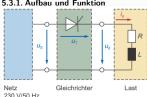
N: verkettet Größe

### 5.2. Welligkeit

$$v_U = \sqrt{\frac{U_{RMS}^2}{U_d^2} - 1}$$

### 5.3. Einphasige Mittelpunktschaltung M1

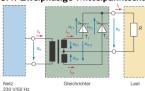
#### 5.3.1. Aufbau und Funktion



5.3.2. Steuergesetz

Rein ohmsche Last:  $U_{di\alpha} = \frac{\hat{U}_{S}}{2\pi} \cdot (1 + \cos \alpha)$ 

### 5.4. Zweiphasige Mittelpunktschaltung M2C

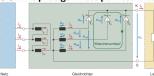


 $u_{s12} = u_{s1} - u_{s2} = u_N \cdot \frac{N_2}{N_1}$ 

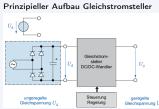
5.4.2. Steuergesetz Bei nicht lückendem Betrieb ergibt sich für  $U_{dia}$ 

 $U_{di\alpha} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{2\pi + \alpha} u_d(\omega t) d(\omega t) = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot \hat{U}_S \cdot \cos \alpha$ 

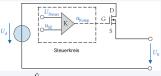
# 5.5. Dreiphasige Mittelpunktschaltung M3C



# 6. Gleichstromsteller im Einquadrantenbetrieb



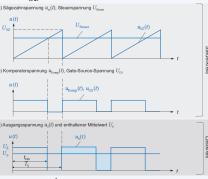
### Grundschaltung Tiefsetzsteller



$$u_{SZ}(t) = \frac{U_{SZ}}{T_{S}} \cdot t = U_{Stee}$$

$$\frac{\sigma_{SZ}}{T_S} \cdot t_{ein} = U_{Steue}$$

$$_{in} = \frac{OSteuer}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T$$



Tastgrad:  $D = \frac{t_{Ein}}{T_c}$ 

### Schaltbedingung:

 $u_{Komp} > 0 \Rightarrow MOSFET$  eingeschaltet  $u_0(t) = U_d$  $u_{Komp} < 0 \Rightarrow MOSFET$  ausgeschaltet  $u_0(t) = 0$ 

Mittelwert der Ausgangsspannung:  $U_0 = \frac{t_{ein}}{T_a} \cdot U_d = D \cdot U_d$ 

$$T_S = \frac{1}{f_S}$$

$$t_{Ein} = \frac{U_{Steuer}}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T_S$$